



①⑨ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ **Off nlegungsschrift**
⑩ **DE 198 27 414 A 1**

⑤① Int. Cl.⁶:
C 04 B 41/90
C 04 B 41/91
H 01 L 23/15

②① Aktenzeichen: 198 27 414.9
②② Anmeldetag: 19. 6. 98
④③ Offenlegungstag: 23. 12. 99

DE 198 27 414 A 1

⑦① Anmelder:
Schulz-Harder, Jürgen, Dr.-Ing., 91207 Lauf, DE

⑦④ Vertreter:
Patentanwälte Wasmeier, Graf, 93055 Regensburg

⑦② Erfinder:
gleich Anmelder

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤④ Verfahren zum Herstellen eines Metall-Keramik-Substrates

⑤① Die Erfindung bezieht sich auf ein neuartiges Verfahren zum Herstellen eines Metall-Keramik-Substrates, bei dem wenigstens eine Oberflächenseite einer Keramikschiicht mit wenigstens einer ersten, strukturierten Metallschicht versehen und auf diese durch stromloses, chemisches Abscheiden wenigstens eine zweite Metallschicht aufgebracht wird, und bei dem in die Keramikschiicht durch Laserbearbeitung wenigstens eine Sollbruchlinie bildende Einkerbung und/oder eine Vielzahl von aneinander anschließenden, die Sollbruchlinie bildenden Löchern oder Vertiefungen eingebracht werden.

DE 198 27 414 A 1

Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Herstellen eines Metall-Keramik-Substrates für elektrische Schaltkreise oder Bauelemente gemäß Oberbegriff Patentanspruch 1.

Bekannt ist es, die zum Herstellen von Leiterbahnen, Anschlüssen usw. benötigte Metallisierung auf einer Keramik, z. B. auf einer Aluminium-Oxid-Keramik mit Hilfe des sogenannten "DCB-Verfahrens" (Direct-Copper-Bond-Technology) herzustellen, und zwar unter Verwendung von die Metallisierung bildenden Metall- bzw. Kupferfolien oder Metall- bzw. Kupferblechen, die an ihren Oberflächenseiten eine Schicht oder einen Überzug (Aufschmelzschicht) aus einer chemischen Verbindung aus dem Metall und einem reaktiven Gas, bevorzugt Sauerstoff aufweisen. Bei diesem beispielsweise in der US-PS 37 44 120 oder in der DE-PS 23 19 854 beschriebenen Verfahren bildet diese Schicht oder dieser Überzug (Aufschmelzschicht) ein Eutektikum mit einer Schmelztemperatur unter der Schmelztemperatur des Metalls (z. B. Kupfers), so daß durch Auflegen der Folie auf die Keramik und durch Erhitzen sämtlicher Schichten diese miteinander verbunden werden können, und zwar durch Aufschmelzen des Metalls bzw. Kupfers im wesentlichen nur im Bereich der Aufschmelzschicht bzw. Oxidschicht.

Dieses DCB-Verfahren weist dann z. B. folgende Verfahrensschritte auf:

- Oxidieren einer Kupferfolie derart, daß sich eine gleichmäßige Kupferoxidschicht ergibt;
- Auflegen des Kupferfolie auf die Keramikschicht;
- Erhitzen des Verbundes auf eine Prozeßtemperatur zwischen etwa 1065 bis 1083°C, z. B. auf ca. 1071°C;
- Abkühlen auf Raumtemperatur.

Bekannt ist weiterhin die Laserbearbeitung bzw. -behandlung von Keramik (z. B. Günter Spur "Keramikbearbeitung", Hauser Verlag, ISDN 9-446-15620-8).

Beim Stand der Technik wird die Keramik entweder geschnitten oder durch Einzelimpulse werden in die Keramik sacklochartige Vertiefungen eingebracht, und zwar beispielsweise zum Herstellen von Sollbruchlinien, an denen ein Mehrfach-Substrat in Einzelsubstrate durch Brechen getrennt werden kann. Die Laserbehandlung kann aber auch anderen Zwecken dienen. Der Abstand der Löcher beträgt dann beispielsweise 0,1-0,5 mm und die Eindringtiefe der Behandlung liegt zwischen 2-70% der Keramikdicke.

Für die Laserbearbeitung eignen sich beispielsweise CO₂-Laser oder Nd-YAG-Laser.

Die Herstellung von Metall-Keramik-Substraten mit laserbehandelten Keramikschichten erfolgt bisher, insbesondere auch bei Verwendung des DCB-Verfahrens, wie folgt: Zunächst wird mit dem Laser die blanke, d. h. noch nicht mit einer Metallschicht versehene Keramikschicht entlang der gewünschten Sollbruchlinien behandelt. Im Anschluß daran erfolgt das Aufbringen der ersten Metallschichten, beispielsweise in Form von Kupferfolien und unter Verwendung des DCB-Verfahrens oder eines Aktivlotverfahrens. In einem weiteren Verfahrensschritt wird dann diese erste Metallschicht in der erforderlichen Weise strukturiert, und zwar unter Anwendung bekannter Ätz- und Maskierungstechniken, bei denen zunächst eine Ätzmaske beispielsweise durch Sieb- oder Fotodruck erzeugt und anschließend unter Verwendung dieser Maske durch Ätzen die erforderliche Strukturierung bzw. das erforderliche Layout hergestellt wird.

Auf der strukturierten ersten Metallschicht wird dann z. B. durch stromloses, chemisches Abscheiden in entspre-

chenden Bädern eine weitere Metallschicht erzeugt.

Entlang der durch die Laserbearbeitung erzeugten Sollbruchlinien kann dann das Vielfachsubstrat durch Brechen in die Einzelsubstrate unterteilt werden.

Das bekannte Verfahren, bei dem die Laserbearbeitung vor dem Aufbringen der Metallisierung erfolgt, hat den Nachteil, daß schon am Beginn des Fertigungsprozesses eine produktbezogene Laserbearbeitung von Keramiken notwendig ist und damit auch eine produktbezogene Lagerhaltung, und zwar mit dem Nachteil hoher Lagerhaltungskosten und langer Durchlaufzeiten. Weiterhin besteht die Gefahr, daß die jeweilige laserbehandelte blanke Keramik während des Aufbringens der ersten Metallschichten bzw. während des hierfür notwendigen Handling in unerwünschter Weise bricht.

Wird die Laserbearbeitung als letzten Schritt am Ende des Herstellungsprozesses, d. h. nach dem stromlosen chemischen Abscheiden der zweiten Metallschichten vorzusehen, hat dies den Nachteil, daß die Substratoberfläche durch das Plasma, welches bei der Laserbearbeitung frei wird, stark verschmutzt. Durch längere Verweilzeiten und/oder durch die Erhitzung während der Laserbearbeitung kommt es auch in unerwünschter Weise zu einer Korrosion der Oberfläche der von den Metallschichten gebildeten Metallisierungen, was die weitere Verwendung des Substrates beeinträchtigt, beispielsweise zu einer verminderten Lötbarkeit oder Drahtbondbarkeit der Oberfläche der Metallisierungen führt.

Versuche, die Laserbearbeitung nach dem Strukturieren der ersten Metallflächen und vor dem stromlosen bzw. chemischen Aufbringen der weiteren Metallschichten vorzunehmen, haben bisher zu keinen brauchbaren Ergebnissen geführt. Insbesondere hat sich gezeigt, daß an den Rändern und am Boden der bei der Laserbearbeitung erzeugten Ritzen bzw. Einkerbungen oder Bohrungen bei der stromlosen, chemischen Abscheidung ebenfalls Metall abgeschieden wird. Diese unerwünschte Metallbeschichtung, die sich nach dem Trennen des Mehrfachsubstrates in die Einzelsubstrate am Rand der Einzelsubstrate befindet, führt dort zu einer Reduzierung der Spannungsfestigkeit zwischen der Oberseite und Unterseite der Einzelsubstrate.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren aufzuzeigen, welches die Nachteile der bekannten Verfahren, insbesondere auch eine aufwendige produktbezogene Lagerhaltung von Keramiken vermeidet.

Zur Lösung dieser Aufgabe ist ein Verfahren entsprechend dem Patentanspruch 1 ausgebildet.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren erfolgt die Laserbearbeitung nach der Strukturierung der wenigstens einen ersten Metallschicht und vor dem stromlosen, chemischen Aufbringen der wenigstens einen zweiten Metallschicht.

Es hat sich überraschenderweise gezeigt, daß während der stromlosen, chemischen Abscheidung der wenigstens einen weiteren Metallschicht an den Rändern und Böden der bei der Laserbehandlung erzeugten Ritzen bzw. Einkerbungen und Vertiefungen kein Metall abgeschieden wird, wenn die Laserbearbeitung entsprechend dem erfindungsgemäßen Verfahren erfolgt, d. h. insbesondere unter einer Atmosphäre, die wenigstens 30% Sauerstoff enthält.

Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.

Die Erfindung wird im folgenden anhand der Figuren an einem Ausführungsbeispiel näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 ein nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestelltes strukturiertes Substrat;

Fig. 2-7 die wesentlichen Verfahrensschritte zum Herstellen des Substrates der Fig. 1.

Das in der Fig. 1 allgemein mit 1 bezeichnete Mehrfach-

substrat besteht im wesentlichen aus einer rechteckförmigen oder quadratischen Keramikschicht oder Keramikplatte 2, die beispielsweise eine Aluminiumoxid-Keramik oder aber eine andere Keramik, z. B. ALN, Si_3N_4 oder SiC ist. An der oberen und unteren Oberflächenseite der Keramikschicht 2 ist jeweils eine Metallisierung 3 bzw. 4 vorgesehen, die in der erforderlichen Weise strukturiert sind, und zwar bei der dargestellten Ausführungsform in der Weise, daß die Metallisierungen 3 und 4 jeweils einzelne Metallisierungen 3' bzw. 4' bilden, die an der Ober- und Unterseite der Keramikschicht in mehreren parallel zu den Umfangsseiten der Keramikschicht 2 verlaufenden Reihen und Spalten vorgesehen sind. Die einzelnen Metallisierungen 3' und 4' an der Oberseite und Unterseite der Keramikschicht 2 sind durch die Strukturierung jeweils voneinander getrennt, und zwar an streifenförmigen, parallel zu den Umfangsseiten der Keramikschicht 2 verlaufenden Bereichen 5, an denen die Keramik freiliegt. An den Bereichen 5 ist die Keramikschicht 2 weiterhin oben und unten jeweils mit von Einkerbungen 6 gebildeten Sollbruchlinien versehen. Einer Einkerbung 6 an der Oberseite der Keramikschicht 2 liegt eine Einkerbung 6 an der Unterseite dieser Keramikschicht gegenüber.

Durch die von den Einkerbungen 6 gebildeten Sollbruchlinien kann das Substrat 1 durch Brechen in Einzelsubstrate getrennt werden, die jeweils aus den Einzelmetallisierungen 3' und 4' und dem dazwischenliegenden Teil der Keramikschicht 2 bestehen. Die Einkerbungen 6 sind durch Laserbearbeiten oder durch Laser-Ritzen, d. h. unter Verwendung eines Lasers, beispielsweise eines CO₂-Lasers oder eines Nd-YAG-Lasers hergestellt. Anstelle von durchgehenden Einkerbungen 6 können auch punktförmige, jeweils in Längsrichtung des jeweiligen Bereichs 5 aufeinanderfolgende Vertiefungen oder Löcher durch Einbrennen mittels des Lasers in der Keramikschicht 2 erzeugt sein, wobei diese Löcher dann in ihrer Gesamtheit wiederum die jeweilige Sollbruchlinie bilden.

Die Metallisierungen 3 und 4 und damit auch die Einzelmetallisierungen 3' und 4' bestehen jeweils aus einer Kupferschicht 7, die flächig unmittelbar mit der betreffenden Oberflächenseite der Keramikschicht 2 verbunden ist und beispielsweise eine Dicke von 200–500 µ aufweist, sowie aus einer Oberflächenmetallisierung oder Metallschicht 8, die durch stromloses und chemisches Abscheiden von Metall auf der Kupferschicht 7 erzeugt ist und eine Dicke aufweist, die kleiner als die Dicke der Kupferschicht 7. Die Metallschicht 8 besteht beispielsweise aus Nickel und/oder Palladium und/oder Zinn und/oder Gold und/oder Kupfer.

Bevorzugt wird das Mehrfachsubstrat 1 so verwendet, daß die Einzelmetallisierungen 3' bzw. 4' zunächst mit einer üblichen Technik, beispielsweise Maskierungs- und Ätztechnik in der erforderlichen Weise strukturiert werden und das Mehrfachsubstrat 1 erst anschließend oder aber nach einer Bestückung mit elektrischen Bauelementen entlang der von den Einkerbungen 6 oder Löchern gebildeten Sollbruchstellen an den Bereichen 5 in die Einzelsubstrate durch Brechen zertrennt wird.

Das Herstellen des Mehrfachsubstrates 1 erfolgt beispielsweise in der nachstehend im Zusammenhang mit den Fig. 2–7 beschriebenen Weise:

Entsprechend Fig. 2 wird die Keramikschicht 2 an ihrer Ober- und Unterseite jeweils mit einer Kupferschicht 7 versehen, die sich zunächst über die gesamte Fläche der Ober- und Unterseite der Keramikschicht 2 erstreckt. Die Kupferschichten 7 sind beispielsweise von Kupferfolien mit einer Dicke zwischen 200–500 µ gebildet, die mit Hilfe der DCB-Technik oder aber mit Hilfe einer anderen, dem Fachmann bekannten Technik, beispielsweise mit Hilfe des Aktiv-Löt-Verfahrens aufgebracht sind. Grundsätzlich besteht auch die

Möglichkeit, zumindest eine der beiden Kupferschichten 7 als Kupferdickschicht nach dem bekannten Dickschichtverfahren herzustellen.

Die Keramikschicht 2 kann, wie oben ausgeführt ist, eine Keramik unterschiedlichen Typs sein, z. B. Al_2O_3 , ALN, Si_3N_4 , SiC.

Entsprechend den Fig. 3 und 4 erfolgt in weiteren Verfahrensschritten die Strukturierung der Kupferschichten 7, insbesondere zur Herstellung der Bereiche 5, an denen die Keramikschicht 2 dann freiliegt und von denen bei der dargestellten Ausführungsform jeweils ein Bereich 5 an der Oberseite der Keramikschicht 2 einem Bereich 5 an der Unterseite der Keramikschicht 2 gegenüberliegt. Diese Strukturierung erfolgt mit der bekannten Ätztechnik. Hierzu wird auf die freiliegenden Oberflächenseiten der Kupferschichten 7 jeweils eine Schicht aus einem Fotolack aufgebracht, der eine Ätz-Maske 9 bildet, die die Kupferschichten 7 an den nicht zu ätzenden Brechen abdeckt. Durch Ätzen und anschließendes Entfernen der Maske 9 werden die Bereiche 5 in den Kupferschichten 7 erzeugt, an denen die Keramikschicht 2 freiliegt.

In einem weiteren Verfahrensschritt erfolgt entsprechend der Fig. 5 die Laserbearbeitung, d. h. das Einbringen der Einkerbungen 6 bzw. der entsprechenden Löcher zumindest an der einen Oberflächenseite der Keramikschicht 2 entlang der dortigen Bereiche 5. Bei der dargestellten Ausführungsform erfolgt diese Laserbearbeitung auf beiden Seiten der Keramikschicht 2, und zwar beispielsweise zunächst an der Oberseite und dann nach einem Wenden auch an der Unterseite, so daß das in der Fig. 6 dargestellte Ergebnis erhalten wird. Wesentlich hierbei ist, daß die Laserbearbeitung in einer Atmosphäre erfolgt, die einen hohen Anteil an Sauerstoff, d. h. mindestens 30–35% Sauerstoff enthält. Hierfür wird für die Laserbearbeitung eine Düse 10 verwendet, durch die der Laserstrahl 11 hindurchgeführt ist und an der ein Gasstrom 12 austritt und unmittelbar auf den Bereich auftritt, an dem die Behandlung der Keramikschicht 2 mit dem Laserstrahl 11 gerade durchgeführt wird. Der Gasstrom 12 ist beispielsweise mit Sauerstoff angereicherte Luft oder aber technischer Sauerstoff.

Es hat sich gezeigt, daß durch die Laserbearbeitung in der Sauerstoffatmosphäre offenbar Keime im Bereich der Einkerbungen 6 wirksam verhindert werden, die bei dem späteren stromlosen bzw. chemischen Aufbringen der Metallschicht 8 ein unerwünschtes Abscheiden von Metall an den Einkerbungen 6 bewirken könnten.

Die Düse 10 ist mit ihrem unteren, offenen Düsenende 10' möglichst dicht am Substrat angeordnet, beispielsweise in einem Abstand von höchstens 5 mm. Der Druck in der Düse 10 beträgt wenigstens 50 Kilo-Pascal.

Entsprechend der Fig. 7 wird dann in einem stromlosen Verfahrensschritt chemisch die Metallschicht 8 abgeschieden, und zwar nur dort, wo dieses Substrat für die chemische Abscheidung aktiviert ist, nämlich auf den freiliegenden Oberflächen der strukturierten Kupferschicht 7. Durch die Beaufschlagung der Oberfläche der Keramikschicht 2 bei der Laserbearbeitung mit Sauerstoff erfolgt bei diesem stromlosen, chemischen Metallauftrag an den Bereichen 5 und auch an den Einkerbungen 6 kein Metallauftrag, so daß insbesondere auch für die hergestellten Einzelsubstrate die erforderliche Spannungsfestigkeit gegeben ist, obwohl die Laserbearbeitung zur Erzielung der Sollbruchlinien (Einkerbungen 6 oder Laser-Löcher) erst nach dem Aufbringen der Kupferschichten 7 und deren Strukturierung vorgenommen wird. Das vorbeschriebene Verfahren bietet insbesondere auch den Vorteil, daß unter Verwendung von mit den Kupferschichten 7 bereits versehenen Keramikschichten 2 das Layout des jeweiligen Mehrfachsubstrates 1 bzw. die Her-

stellung der Einzelmetallisierungen 3' und 4' jeweils individuell den speziellen Anforderungen oder Kundenwünschen entsprechend erfolgen kann, was nicht möglich wäre, wenn die Sollbruchlinien bzw. die entsprechenden Einkerbungen 6 oder Laser-Löcher bereits vor dem Aufbringen der ersten, flächigen Metallschicht (Kupferschichten 7) und vor dem Strukturieren dieser Metallisierung erfolgen würde.

Zu dem vorbeschriebenen Verfahren sind verschiedene Modifikationen oder zusätzliche Verfahrensschritte denkbar. So ist es beispielsweise möglich, vor dem stromlosen, chemischen Metallauftrag (Metallschicht 8), bevorzugt nach der Laserbearbeitung die Oberfläche des Substrates und dabei insbesondere auch dessen Kupferoberfläche durch eine alkalische Behandlung zu reinigen und/oder bei der Laserbearbeitung entstandene Reste zu entfernen und/oder die Oberfläche der Kupferschichten 7 geringfügig abzuätzen, wobei die Dicke der bei diesem Abätzen entfernten Kupfer- teilschicht z. B. 0,1–50 µm beträgt.

Anstelle dieser Oberflächenbehandlung oder zusätzlich hierzu ist es weiterhin auch möglich, die Oberfläche der Kupferschichten 7, auf denen die Metallschicht 8 chemisch und stromlos abgeschieden werden soll, hierfür in geeigneter Weise zu aktivieren.

Für den stromlosen, chemischen Metallauftrag eignet sich beispielsweise Ni-Phosphor oder Ni-Bohr mit Palladium-Chlorid eine Aktivierung aber auch chemisch abgeschiedenes Zinn und/oder Kupfer.

Weiterhin besteht auch die Möglichkeit, auf die Metallschicht 8 wenigstens eine weitere Metallschicht aufzubringen, und zwar wiederum durch stromlosen, chemischen Metallauftrag. Diese weitere Metallschichten können dann beispielsweise Gold, Palladium usw. sein.

Wie Fig. 5 verdeutlicht wird durch die Strukturierung der Kupferschicht 7 bei der Laserbearbeitung der aus der Düse 10 ausgebrachte Sauerstoff im jeweiligen Bereich 5 gegen zu schnelles Entweichen zurückgehalten, so daß sich eine relativ lange Verweilzeit für den Sauerstoff am Ort der Laserbearbeitung erreicht wird.

Die Erfindung wurde voranstehend an Ausführungsbeispielen beschrieben. Es versteht sich, daß weitere Abwandlungen möglich sind, ohne daß der der Erfindung zugrundeliegende Erfindungsgedanke verlassen wird.

Bezugszeichenliste

1 Mehrfachsubstrat	45
2 Keramikschicht	
3, 4 Metallisierung	
3', 4' Einzelmetallisierung	
5 freiliegender Bereich der Keramikschicht	50
6 Einkerbung	
7 Kupferschicht	
8 Metallschicht	
9 Maske	
10 Düse	55
10' Düsenöffnung	
11 Laserstrahl	
12 Gasstrahl mit hohem Sauerstoffanteil	

Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen eines Metall-Keramik-Substrates, bei dem wenigstens eine Oberflächenseite einer Keramikschicht (2) mit wenigstens einer ersten, strukturierten Metallschicht (7) versehen und auf diese durch stromloses, chemisches Abscheiden wenigstens eine zweite Metallschicht (8) aufgebracht wird, und bei dem in die Keramikschicht (2) durch Laserbearbeitung

wenigstens eine eine Sollbruchlinie bildende Einkerbung (6) und/oder eine Vielzahl von aneinander anschließenden, die Sollbruchlinie bildenden Löchern oder Vertiefungen eingebracht werden, dadurch gekennzeichnet, daß die Laserbearbeitung nach dem Herstellen der ersten, strukturierten Metallschicht (7) erfolgt, und zwar in einer Atmosphäre, die mindestens 30% Sauerstoff enthält.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß beide Oberflächenseiten der Keramikschicht (2) jeweils mit der ersten, strukturierten Metallschicht (7) versehen werden und auf wenigstens eine erste Metallschicht (7) die wenigstens eine zweite Metallschicht (8) stromlos abgeschieden wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß an beiden Oberflächenseiten der Keramikschicht jeweils eine Laserbearbeitung erfolgt.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Metallschicht (7) durch eine Ätz- und Maskierungstechnik strukturiert wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Metallschicht (7) in Form einer Metallfolie mittels des Direct-Bonding-Verfahrens aufgebracht wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Metallschicht (7) in Form einer Metallfolie unter Verwendung eines Aktiv-Löt-Verfahrens aufgebracht wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Metallschicht (7) mit Hilfe einer Dickschichttechnik aufgebracht wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Metallschicht (7) aus Kupfer oder einer Kupferlegierung besteht.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Metallschicht (7) mit einer Dicke von 200–500 µm aufgebracht wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Keramikschicht (2) aus wenigstens einer Keramik der Gruppe Al_2O_3 , AlN , Si_3N_4 , Sic besteht.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß für die Laserbearbeitung ein Laser mit einer Wellenlänge von etwa 10 µm, beispielsweise 10,6 µm, z. B. ein CO_2 -Laser verwendet wird.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß für die Laserbehandlung ein Laser mit einer Wellenlänge von etwa 1 µm, beispielsweise 1,06 µm, z. B. ein Nd-YA6-Laser verwendet wird.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Substrat vorzugsweise nach der Laserbearbeitung chemisch und/oder mechanisch gereinigt wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Reinigung durch alkalische Behandlung und/oder durch Abätzen einer dünnen Oberflächenteilschicht der ersten Metallschicht erfolgt.

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß vor dem chemischen Abscheiden der wenigstens einen zweiten Metallschicht eine Aktivierung der Oberfläche der ersten Metallschicht erfolgt.

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die chemische Abscheidung bzw. Metallisierung unter Verwendung von Ni-Phospor oder Ni-Bohr mit Aktivierung durch Palladiumchlorid/ oder durch chemisches Zinn- und/ oder chemisches Kupfer erfolgt. 5

17. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest auf einem Teil der zweiten Metallschicht (8) durch eine chemische stromlose Abscheidung wenigstens eine weitere Metallschicht (8) erzeugt wird. 10

18. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als zweite Metallschicht (8) und/oder als weitere Metallschicht Gold und/oder Palladium durch chemisches Abscheiden aufgebracht wird. 15

19. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Laserbehandlung in einem Luft- oder Gasstrom erfolgt, der mit Sauerstoff angereichert ist. 20

20. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Laserbehandlung in einem Strom aus Sauerstoff bzw. technischen Sauerstoff erfolgt.

21. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Laserbearbeitung durch eine Düse (10) erfolgt, aus deren Öffnung zusätzlich zum Laserstrahl (11) auch der Luft- oder Gasstrom (12) austritt. 25

22. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand der Düse zum Substrat bei der Laserbehandlung gleich oder kleiner 5 mm ist. 30

23. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Düse mit einem Gasdruck von wenigstens 50 kPa beaufschlagt ist. 35

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

40

45

50

55

60

65

- Leerseite -

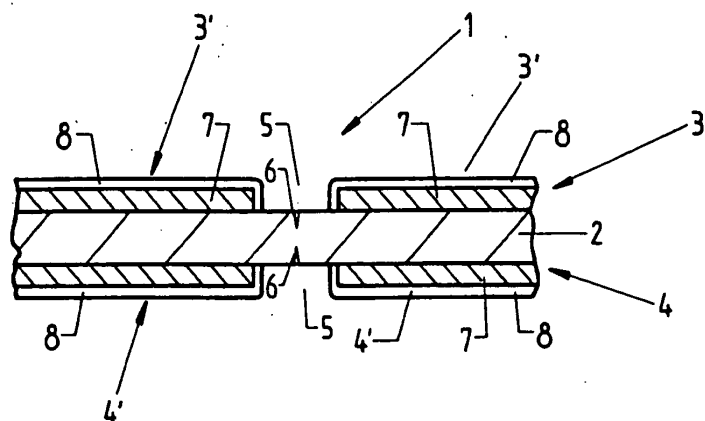


FIG. 1

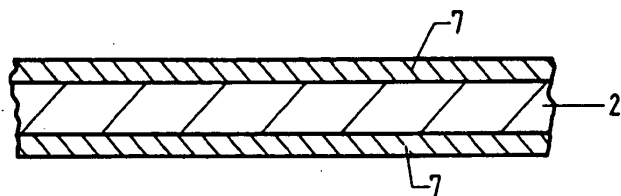


FIG. 2

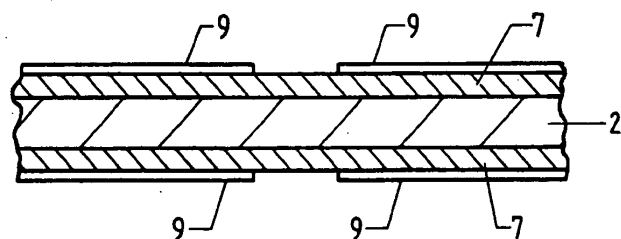


FIG. 3

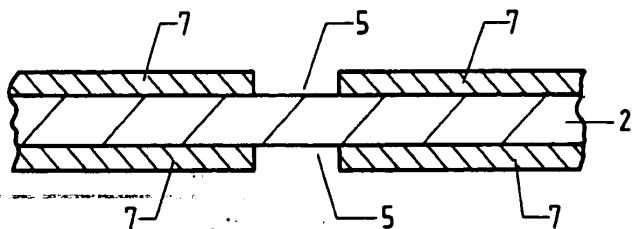


FIG. 4

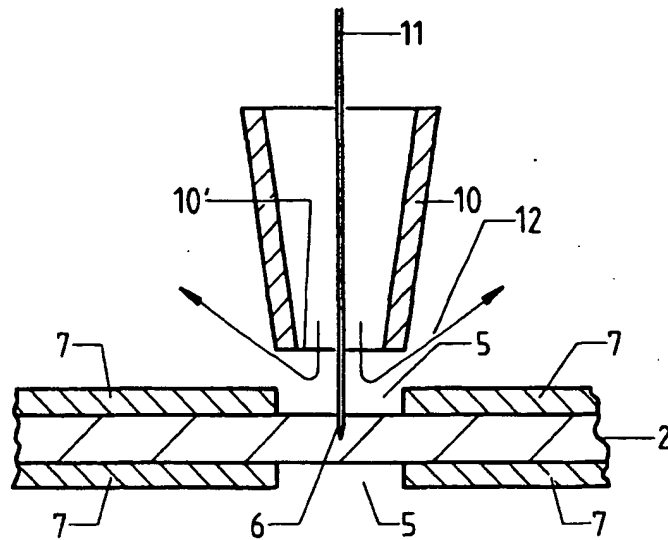


FIG. 5

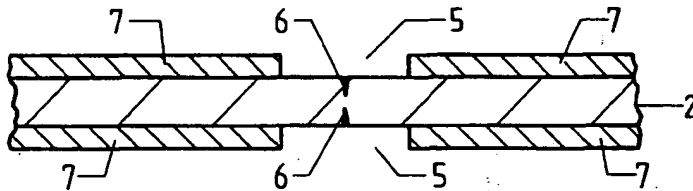


FIG. 6

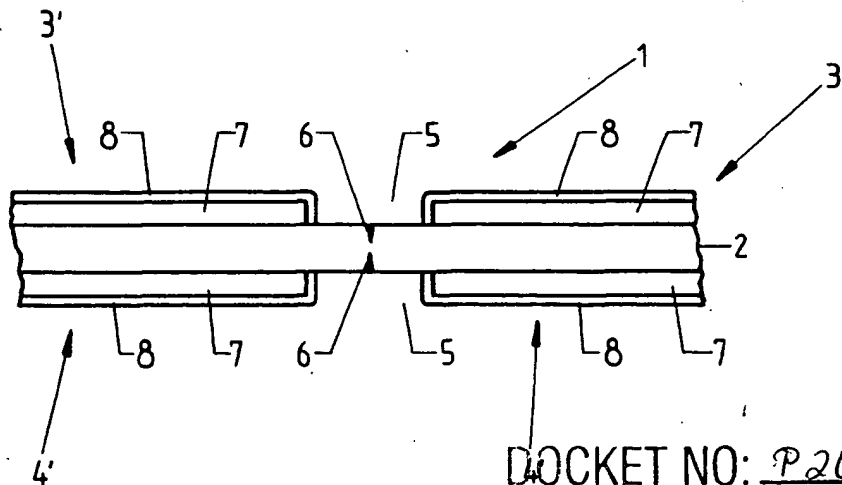


FIG. 7

DOCKET NO: P2000, 0171
SERIAL NO: 09/932, 878
APPLICANT: Acklin et al.
LERNER AND GREENBERG P.A.
P.O. BOX 2480
HOLLYWOOD, FLORIDA 33022
TEL. (954) 925-1100